



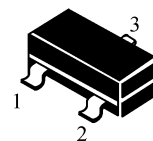
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBTA94(銷售型號 MMBTA94)

SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP High Voltage Transistor

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓	V_{CEO}	-400	V
Collector-Base Voltage 集電極-極電壓	V_{CBO}	-400	V
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	V_{EBO}	-7	V
Collector Current 集電極電流	I_C	-200	mA
Device Dissipation 耗散功率	P_D	225	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55to+125	°C

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓($I_C=-1\text{mA}, I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$	-400	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓($I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$	-400	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓($I_E=-100\mu\text{A}, I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$	-7	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=-400\text{V}, I_E=0$)	I_{CBO}	—	-500	nA
DC Current Gain 直流電流增益 ($I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-10.0\text{V}$)	H_{FE}	40	240	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ($I_C=-20\text{mA}, I_B=-2\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	-0.6	V
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ($I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-20\text{V}, f=30\text{MHz}$)	f_T	50	—	MHz



桂林斯壯微電子有限責任公司

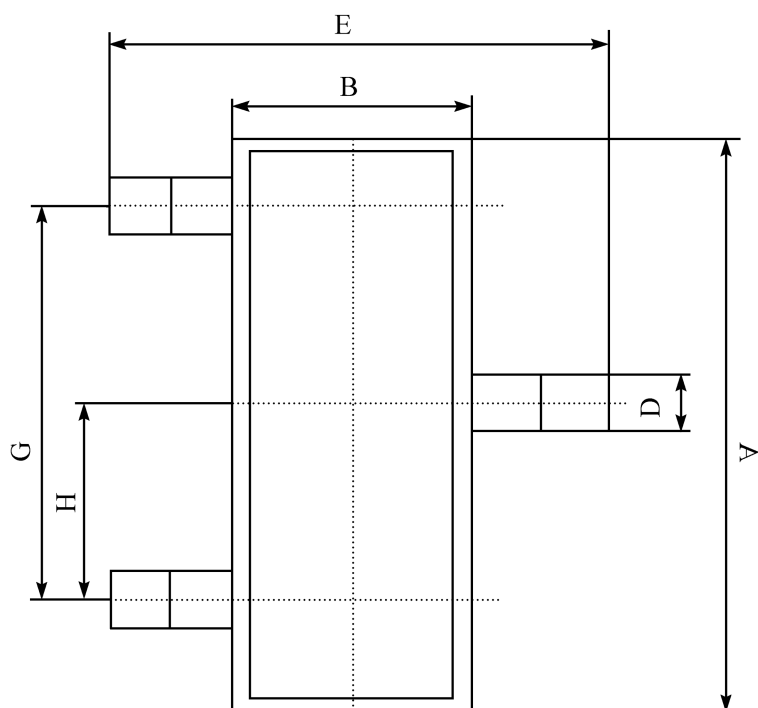
Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBTA94(銷售型號 MMBTA94)

■DEVICE MARKING 打標

GMBTA94(銷售型號 MMBTA94)=4D

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

